

## 2SD610/2SB630

NPN/PNP 三重拡散形シリコントランジスタ

NPN/PNP SILICON TRIPLE DIFFUSED TRANSISTOR

低周波電力増幅用 / Audio Frequency Power Amplifier

## 特 徴 / FEATURES

- ・実効出力200W~300W高級ステレオパワーアンプのドライバ段として最適。  
Suitable for driver of 200 to 300 watts audio amplifier.
- ・高耐圧である。  
High breakdown voltage.  $V_{CEO}=200V$

絶対最大定格 / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ( $T_a=25^\circ C$ )

項 目	略 号	2SB630	2SD610	単 位
コレクタ・ベース間電圧	$V_{CBO}$	-200	250	V
コレクタ・エミッタ間電圧	$V_{CEO}$	-200	200	V
エミッタ・ベース間電圧	$V_{EBO}$	-5.0	5.0	V
コレクタ電流 (直流)	$I_{C(DC)}$	-2.0	2.0	A
コレクタ電流 (パルス)	$I_{C(Pulse)}$ *	-3.0	3.0	A
全損失	$P_T(T_C=25^\circ C)$	25		W
全損失	$P_T(T_a=25^\circ C)$	1.5		W
ジャンクション温度	$T_j$	150		$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55~+150		$^\circ C$

\*  $PW \leq 10ms$  duty cycle  $\leq 50\%$ 電気的特性 / ELECTRICAL CHARACTERISTICS ( $T_a=25^\circ C$ )

2SB630/2SD610

項 目	略 号	条 件	MIN.	TYP.	MAX.	単 位
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB}=150V, I_E=0$			-1.0/1.0	$\mu A$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB}=3.0V, I_E=0$			-1.0/1.0	$\mu A$
電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE}=10V, I_C=5.0mA^*$	20			
	$h_{FE2}$	$V_{CE}=10V, I_C=500mA^*$	40	80	200	
コレクタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA^*$		-0.6/0.3	-1.0/1.0	V
ベース飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA^*$		-0.8/0.8	-1.5/1.5	V
帯域幅	$f_T$	$V_{CE}=10V, I_C=500mA$		4/5		MHz
コレクタ容量	$C_{ob}$	$V_{CB}=10V, I_E=0, f=1.0MHz$		65/45		pF

\* パルス測定  $PW \leq 350\mu s$ , duty cycle  $\leq 2\%$  / Pulsed $h_{FE}$  区分 /  $h_{FE}$  Classification $h_{FE2}/S: 40\sim 80$  R:  $60\sim 120$  Q:  $100\sim 200$